**Гайдар Галина Петрівна. Вплив ядерного опромінення та теплових полів на кінетику електронних процесів і дефектоутворення в Si і Ge.- Дис. д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07, НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2014.- 320 с.**